【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年11月29日(2012.11.29)

【公開番号】特開2010-271687(P2010-271687A)
【公開日】平成22年12月2日(2010.12.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-048
【出願番号】特願2009-238211(P2009-238211)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｆ　1/13357　(2006.01)
Ｇ０２Ｆ　1/13　(2006.01)
Ｇ０３Ｂ　21/00　(2006.01)
Ｇ０３Ｂ　21/14　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｆ　1/13357
Ｇ０２Ｆ　1/13　５０５
Ｇ０３Ｂ　21/00　Ｅ
Ｇ０３Ｂ　21/14　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月12日(2012.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
かかる製造プロセスでは、上述したように、ＴＦＴ素子２５１のゲート酸化膜形成のプロセス温度が６００℃～１０００℃であるため、第２マイクロレンズ２４４Ｍの無機膜２４４ａも、６００℃～１０００℃の高温でアニールされることになる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
なお、ここでは、第２マイクロレンズ３４４Ｍの形成位置を透明電極３５２直下の層間絶縁膜３４６中として説明したが、形成位置はこれに限定されるものではない。例えば、図１０において表面遮光膜３５０’と信号線３８５間の層間絶縁膜３９２中に形成されても良い。